

2SB529

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形

概要

2SB529は、シリコン樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャルプレーナ形パワートランジスタで、コレクタ損失は5W(100×100×2mmアルミニウム放熱板つき、周囲温度25℃)、コレクタ電流は-2Aです。大電流での直流電流増幅率の低下が非常に少ないので、低歪率の出力が得られ、カーステレオ等の出力用として、2SD359とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特長

- 大電流での h_{FE} の低下が非常に少ない
- コレクタ電流が大きい($I_C = -2A$ 、 $I_{CM} = -3A$)
- Knee特性が良い($V_{CE} \leq -1V$)

用途

- カーステレオ、カーラジオ、テープレコーダ等の3~10W出力の低周波電力増幅回路

最大定格($T_C = 25^\circ C$)

記号	項目	定格値	単位	
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-40	V	
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-5	V	
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-20	V	
I_C	コレクタ電流	-2	A	
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-3	A	
P_C	コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	1	W
		$T_C = 25^\circ C$	10	W
T_j	接合部温度	150	$^\circ C$	
T_{stg}	保存温度	-55 ~ +150	$^\circ C$	

電気的特性($T_C = 25^\circ C$)

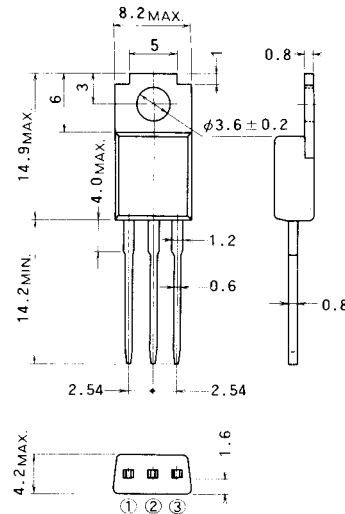
記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -1mA$, $I_E = 0$	-40			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -1mA$, $I_C = 0$	-5			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -10mA$, $R_{BE} = \infty$	-20			V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB} = -25V$, $I_E = 0$			-1	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB} = -5V$, $I_C = 0$			-1	μA
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4V$, $I_C = -0.5A$, パルス測定	55	110	300	
V_{CE}	コレクタ・エミッタ間電圧	$I_C = -1.5A$, $I_B = -0.05A$			-1	V
V_{BE}	ベース・エミッタ間電圧	$V_{CE} = -4V$, $I_B = -0.05A$		-0.7		V

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55-110	90-180	150-300

外形図

単位: mm



電極接続

- ①: ベース EIAJ: -
- ②: コレクタ(放熱板) JEDEC: -
- ③: エミッタ

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。